

TechniStrip® NF52

Photoresist Stripper



TECHNIC

www.technic.com

高溶解性、高金属兼容性、不含 NMP 光刻胶剥离剂

半导体先进封装工艺的发展持续给材料供应商带来新的挑战，除了要求高性能外，还要求材料环保；这就要求须在不牺牲结果的情况下，对传统有害剥离剂进行替换。

历史上，化学物质 如：NMP和羟胺被用于溶解液体和干膜光刻胶，Technic 通过广泛的研究和开发，已开发出TechniStrip®系列产品，产品性能优益、不含NMP和羟胺。

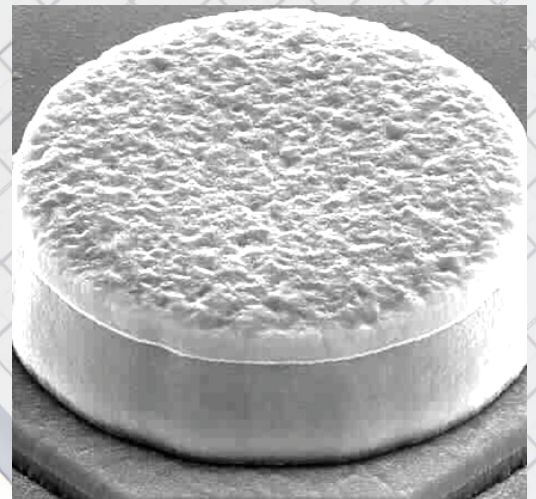
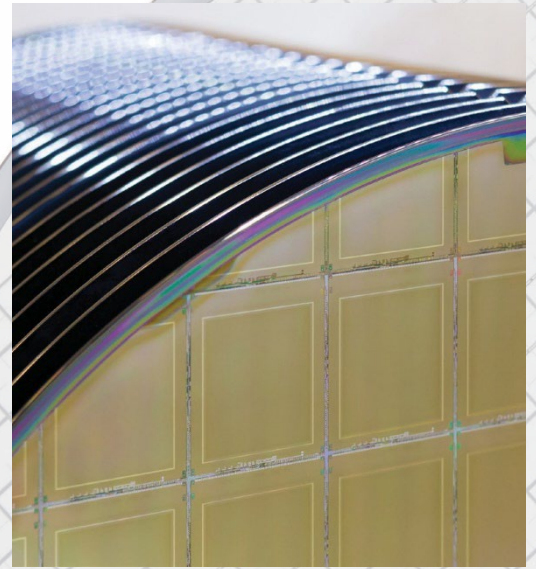
TechniStrip® NF 52对于难去除的干膜光刻胶剥离性能极佳，是许多领先半导体制造商的首选产品。

特性

- 可溶解多数市场上干膜光刻胶
- 可溶解市场上spin-on 光刻胶(N & P Tones)
- 在铜、镍、金 及其它材料上蚀刻率极低
- 兼容III/V 类易损材料 及 有机基材
- 高剥离率 > 10 $\mu\text{m}/\text{minute}$
- 溶液寿命长
- 批量（喷镀、浸镀）和单晶工具上性能均佳

优点

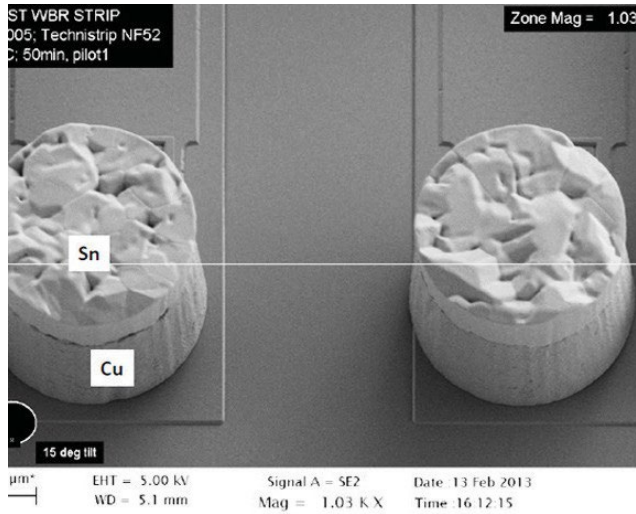
- 工艺效益高、溶液寿命长、操作成本低
- 可充分溶解大多数干膜和液体光刻胶
- 金属兼容性高、工艺窗口宽、操作简易
- 不含CMR (致癌性、诱变性、生殖毒性)，低操作风险



TechniStrip® NF52

DMSO/TMAH Photoresist Stripper

高金属兼容性

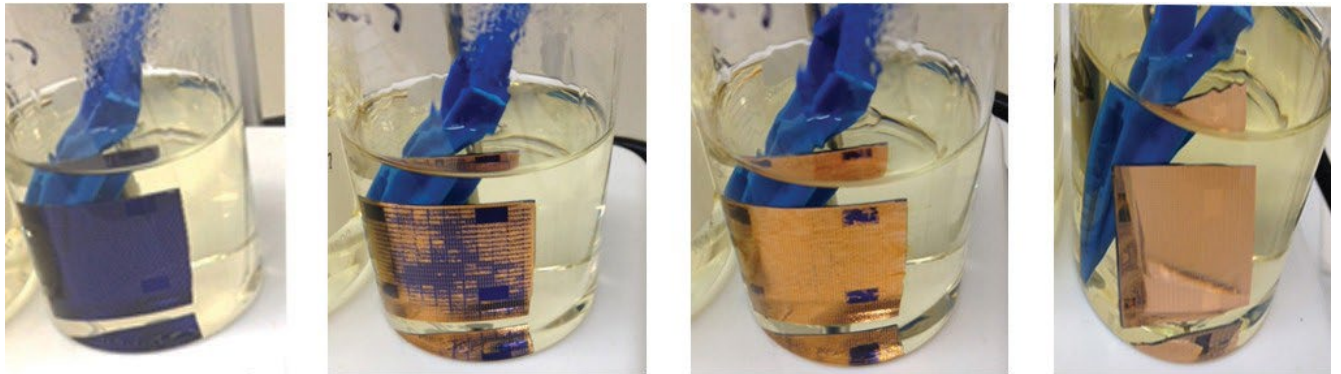
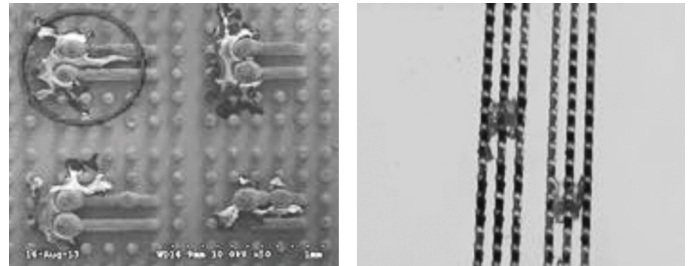


对 WBR 2100 光刻胶测试结果显示: TechniStrip® NF52 具有良好的剥离性, 而对基材无影响

完全溶解干膜光刻胶

随着先进封装工艺特征尺寸的减小和图案的密集, 光刻胶越趋于需被完全溶解, 任何未完全溶解的残留物都将可能导致后续工艺的缺陷问题。

Etch Rate @ 70°C	
基材	静态浸泡 (Å/min)
Al (0.5% Cu)	<2
Al ₂ O ₃ , AlN	<2
Cu	<2
Ni, W	<1
Ta/TaN	<1
Ti/TiN/TiW	<1
Sn, Ag	<1
Pd, Au	<1
Si, TEOS, SiO ₂	<1
ZnO, ITO	<1
GaAs, GaN	<2



如图示, 为使用TechniStrip® NF52 从晶圆上剥离干膜光刻胶的过程, 该工艺完全溶解基板上的光刻胶, 不会在晶片中留下任何残留颗粒或悬浮在溶液中。



www.technic.com